Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Specializarea RST

Circuite Electronice Fundamentale 2 – Proiect Generator de semnal dreptunghiular

Coordonatori: Drăghici Florin

Pantazică Mihaela

Student: Condrea Cosmin

Grupa: 432D-RST

Anul: 2024-2025

Cuprins

Tema Proiectului	pg.	3
Schema Bloc	pg.	4
Schema Electrică	og.	5
Componența Circuitului și Calcule de Dimensionare	pg.	6
Simulări in OrCAD	pg.	9
Layout	pg.	15
Componente	pg.	20
Bibliografie	pg.	21
	Schema Bloc	Tema Proiectului

Tema proiectului

Se proiectează un GENERATOR DE SEMNAL DREPTUNGHIULAR cu următoarele caracteristici: N=9

- Frecvența de oscilație, fo, reglabilă în intervalul: 18÷36 [KHz]
- Factor de umplere: 0.5
- Valoarea (vârf la vârf) a oscilației la ieșire, Vo, reglabilă în intervalul: 0-2.25[V]
- Sarcina la ieșire RL: 9 [kΩ]
- Semnalul la ieșire nu are componentă continuă
- Domeniul temperaturilor de funcționare: 0-70 grade C (verificabil prin testare în temperatură)
- Semnalizarea prezenței tensiunilor de intrare cu diodă de tip LED.

Schema Bloc

Se folosește o schemă de generator de semnal dreptunghiular care este controlat în frecvență și amplitudine cu ajutorul a două potențiometre. Cu ajutorul alimentării (pozitive și negative) se generează semnal dreptunghiular prin intermediul circuitului basculant astabil. Acest semnal trece printr-un etaj de ajustare a semnalului, iar ulterior printr-un divizor de tensiune pentru a putea da tensiunea dorită la ieșire.

Astfel, acest generator de semnal dreptunghiular este capabil să regleze amplitudinea și frecvența oscilațiilor.

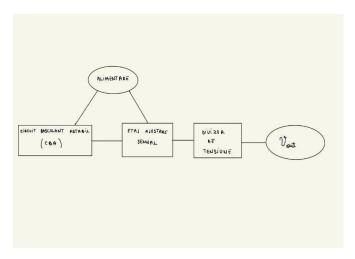


Fig. 1 Schema Bloc

În schema dată, la intrarea în circuitul basculant astabil este folosit un potențiometru pentru reglarea precisă a frecvenței. Semnalul generat urmează să intre în etajul de prelucrare a semnalului, iar cu ajutorul unui divizor de tensiune format din rezistențe și un potențiometru putem regla tensiunea ce cade pe rezistența de sarcină în intervalul de tensiuni dorit.

Toți rezistorii sunt de tip SMD chip 0805 și potențiometrele liniare simplă tură de tip SMD. Condensatoarele sunt de tip ceramic SMD.

Schema Electrică

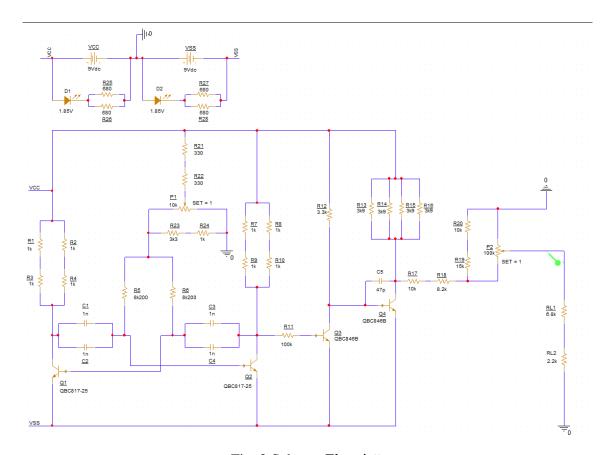


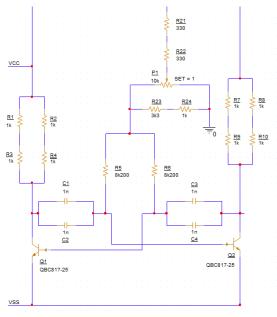
Fig. 2 Schema Electrică

- 1. Circuit basculant astabil: R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , R_{21} , R_{22} , P_1 , R_{23} , R_{24} , C_1 , C_2 , C_3 , C_4 , Q_1 , Q_2 ;
- 2. Etaj de ajustare semnal: Q_3 , Q_4 , C_5 , R_{12} , R_{13} , R_{14} , R_{15} , R_{16} ;
- 3. Divizor de tensiune: R_{17} , R_{18} , R_{19} , R_{20} , P_2 ;
- 4. Circuit pentru semnalizarea tensiunii de la intrare: led $D_1,\,D_2,\,R_{25},\,R_{26},\,R_{27},\,R_{28}$
- 5. Rezistor de sarcină: R_{L1}, R_{L2}

Componența Circuitului și Calcule de Dimensionare

1. Circuitul basculant astabil

Circuitul produce un semnal oscilant periodic, de formă dreptunghiulară, prin alternarea între două stări stabile. Aceste stări se schimbă continuu datorită încărcării și descărcării condensatorilor



din circuit.

La momentul conectării circuitului la sursa de tensiune, unul dintre tranzistori (Q_1) va conduce, iar celălalt (Q_2) va fi blocat. Stările tranzistorilor sunt în comutare alternativă între regimul de saturație și cel de blocare. Când Q_1 este în saturație, curentul de bază al acestuia este dictat de valoarea lui R_6 , ceea ce duce la încărcarea condensatoarelor C_3 și C_4 . În același timp, Q_2 intră în regimul de blocare, astfel, C_1 și C_2 descărcându-se.

Pentru a menține tranzistorii în aceste stări alternative, se folosesc rezistoarele R₁, R₂, R₃, R₄, R₇, R₈, R₉ și R₁₀ pentru a regla curenții de colector și pentru a asigura saturatia corespunzătoare a tranzistorilor.

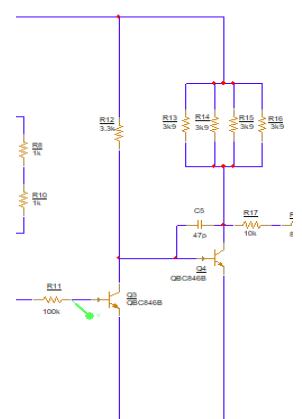
Fig. 3

Cu ajutorul potențiometrului P_1 (cu valoarea efectivă de $3k\Omega$ obținută prin conectarea în paralel a două rezistențe care formează un echivalent de $4.3k\Omega$), se poate regla variația frecvenței oscilatorului între 17,7kHz (când set-ul este 1) și 36,5kHz (când set-ul este 0).

Frecvența oscilatorului este calculată folosind formula: f=1/(2*LN(2)*Rechivalent*C).

În cazul nostru pentru valoarea de 36.5kHz, am nevoie de un $R_{echivalent}$ de $10k\Omega$, unde $R_5 = 8.2k\Omega$, mai trebuie să adaug un rezistor de valoare $1.8k\Omega$ care să și varieze cu ajutorul lui P_1 pentru a modifica frecvența. Tensiunea de alimentare este de 9V, V_{EBQ2} a folosit 0.7V, iar $V_{CE2sat} = 0.02$ V (saturație), peste tot $R_{echivalent}$ cad 17.3V. Prin R_5 trece un curent de 1.7mA. Îl înlăturăm pe R_5 și observăm că pe restul $R_{echivalent} - R_5$ (1.8kΩ) cad 9 – 5.553 \approx 3.5V și implicit curentul de 3.5V : $1.8k\Omega = 1.9$ mA. Pentru a putea păstra 3.5 V, am înlocuit rezistorul de $1.8k\Omega$ cu $0.66k\Omega$, iar astfel curentul a crescut la 5.2mA.

2. Etaj de ajustare semnal



Prin rezistorul R_{11} trece semnalul generat de Circuitul Basculant Astabil. Am ales valoarea de $100k\Omega$ pentru a reduce curentul ce trece prin baza tranzistorului Q_3 . Datorită acestei limitări, semnalul dupa ce trece prin rezistor va prenzenta o variatie a Vbe-ului lui Q_3 . Variatia are ca limita inferioara -8.975 V (de la tensiunea sursei negative) si limita superioara este la deschiderea jonctiunii pn ce permite conductia semnalului. Jonctiunea pn s-ar polariza mai puternic si ar permite mai mult sa treaca, dar R_{11} limiteaza curentul de baza.

Când Q_3 este in conducție curentul va circula pe traseul de jos, scurtcircuitând sursele de tensiune de intrare (într-o anumită măsură, limitat de R_{11} și alte rezistoare din circuit).

În această situație, Q_4 va fi blocat, deoarece tensiunea sa de polarizare (V_{BE}) nu este suficientă pentru a îl aduce în conducție.

Fig. 4

Când Q3 este blocat, Q4 va intra în conducție deoarece tensiunea de polarizare de pe baza sa va fi suficientă pentru a îl activa.

Curentul prin Q4 va fi influențat de V_{ce3} (atunci când acesta e blocat), iar dacă Q3 iese din saturație, tensiunea V_{ce3} va scădea sub pragul necesar, ceea ce va duce la reducerea curentului prin Q4.

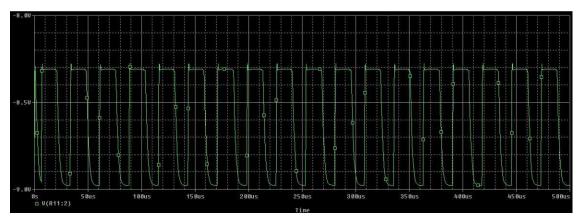
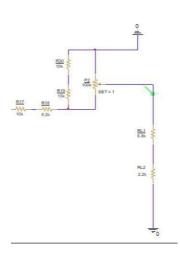


Fig. 5

Am folosit mai multe rezistoare in paralel si serie pentru a putea disipa puterea ce cade pe ele fără a se arde (acestea suportând doar 125mW) și pentru a ajunge la valori standardizate.

Condensatorul C_5 este folosit pentru a contracara efectul Miller. Acesta apare din cauza capacității de feedback(C_μ) (intre baza si colectorul tranzistorului). Din cauza frecvențelor mari această capacitate afeceteaza ieșirea semnalului intrucat semnalul ce trece prin tranzistor devine bidirecțional. Cu ajutorul condesatorului C_5 (condensator de compensare) acest fenomen este contracarat, iar semnalul devine unidirectional.

3. Divizor de tensiune



Divizorul de tensiune este utilizat pentru a controla tensiunea de ieșire aplicată sarcinilor R_{L1} și R_{L2} . Acesta permite ajustarea tensiunii prin utilizarea unui potențiometru P_2 (ce are valoarea efectiva de $20k\Omega$, în urma conectării cu 2 rezistoare in paralel de valori $15k\Omega$, $10k\Omega$), care este configurat împreună cu rezistențele (R_{17} , R_{18} , R_{19} , R_{20}). Acesta reglează în funcție de valoarea set-ului tensiunea de ieșire între valorile de [-50 : 50] (nV) pentru set = 0 și [-2.27 : 2.20] (V) pentru set = 1. Valoarea superioara de 2.20 V, nu atinge valoarea de 2.27 V intrucât este consumată de gruparea de rezistoare (R_{13} , R_{14} , R_{15} , R_{16}).

Fig. 6

4. Circuit pentru semnalizarea tensiunii de la intrare:

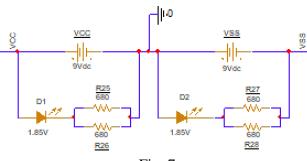


Fig. 7

Am ales diode led KP-2012SRC-PRV de culoare rosie, cu tensiunea de conducție 1.85V. Pentru a se aprinde ledul trebuie să nu depășească curentul maxim (155mA), am ales două cu toleranța de +-1%. Astfel, curentul prin led va fi de 20.93 mA.

Simulări în OrCAD

a) Simulări pentru a prezenta valorile (vârf la vârf) ale oscilației la ieșire și setarea potențiometrului P_2 :

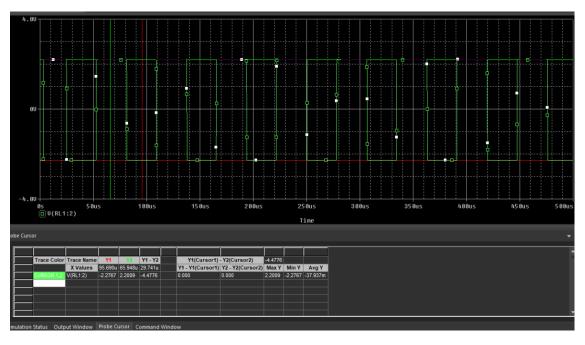


Fig. 8 V_{out} = f(timp) cu SET_{P2} = 1

Tensiunea inferioară măsurată de cursori este de -2.27V, iar cea superioară 2.20V.

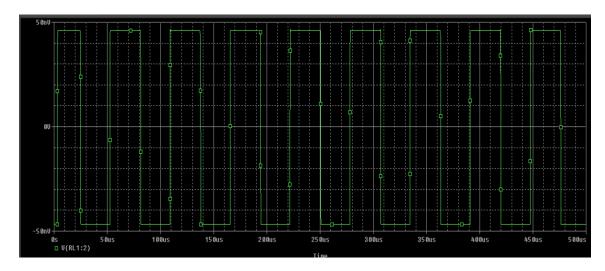


Fig. 9 $V_{out} = f(timp)$ cu $SET_{P2} = 0$

Tensiunea la ieșire ajunge de ordinul nV (aproape 0, neglijabilă).

b) Simulări pentru a prezenta frecvența de oscilație, fo, reglabilă în intervalul [17.58 – 36.49] (kHz)

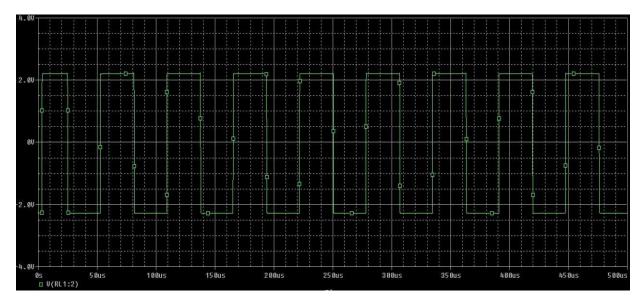


Fig. 10 $V_{out} = f(timp)$ cu $SET_{P1} = 1$

Frecvența se calculează cu ajutorul cursorilor cu formula $f_{oscilatie}$ =1/ $T_{oscilatie}$, unde $T_{oscilatie}$ este egal cu 56.5 μ s => $f_{oscilatie}$ = 17.7 μ kHz.

Duty cycle-ul se calculează cu formula $D=T_{poz}/T$ si se obține 50% cu o eroare de +-0.1%.

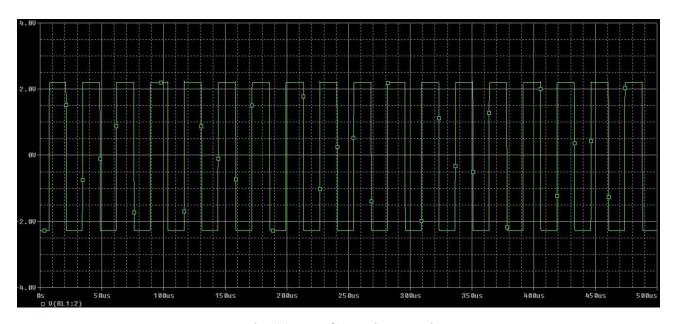


Fig. 11 $V_{out}=f(t)$ cu $SET_{P1}=0$

La fel și in cazul acesta, frecvența o calculez cu ajutorul cursorilor și al formulei $f_{oscilatie}=1/T_{oscilatie}$, unde $T_{oscilatie}$ este egal cu $27.4\mu s=>f_{oscilatie}=36.5kHz$.

c) Simulări pentru a arăta funcționarea circuitului, la valori diferite de temperatură [-20; 25; 100] (°C)

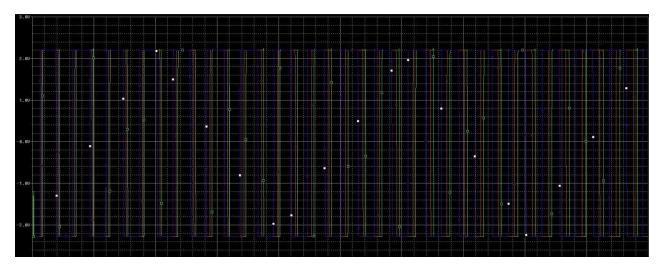


Fig. 12

La temperaturi mai mici, precum -20 °C, componentele semiconductoare (tranzistoarele) au viteze de comutare mai mici, iar rezistențele și condensatoarele își pot modifica valorile (ușor mai mari).

La temperaturi mai mari, efectele termice determină scăderea rezistenței statice a tranzistoarelor, ceea ce duce la viteze de comutare mai rapide, iar capacitățile parazite și componentele pasive (cum ar fi rezistențele) pot avea valori diferite față de cele nominale, modificând frecvența semnalului.

Circuitul este însă relativ stabil, iar frecvența semnalului este doar ușor afectată.

Le considerà C1, C2, C3 goluss:

 Q_1 zi Q_2 comutatie : Q_1 = settuate =) Q_2 = blocare 31 invers

nu putem vorbi de un p la neium transister de pe schuma intrucat micienul nu functioneasa in regim certire normal.

Q3 zi Q4 a comportà asemainator in comulatie

 P_{1} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{1} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{2} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{1} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{1} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{1} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{1} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{1} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{1} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{1} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{2} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{2} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{2} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{2} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{2} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{2} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{2} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{2} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{2} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{3} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{3} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{3} este lémitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{3} este lemitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{3} este lemitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{3} este lemitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{3} este lemitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{3} este lemitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{3} este lemitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{4} este lemitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{4} este lemitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{4} este lemitat au agéntarul resistanteur pure in paralel P_{4} este lemitat au agéntarul resistanteur pure in parale

Cazul 2 Q, Qz - blocere,

Q, Q, - saturalis

Layout

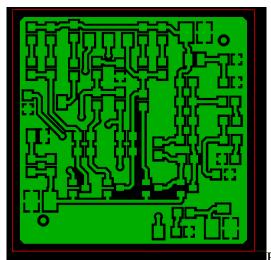


Fig. 13 Layer electric TOP

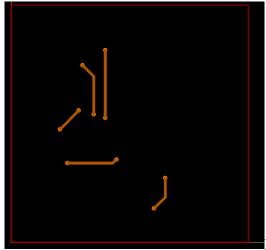


Fig. 14 Layer electric BOTTOM

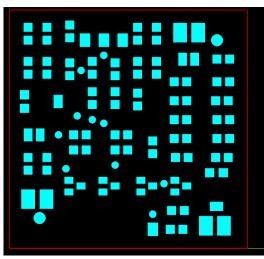


Fig. 15 Layer neelectric Solder Mask Top

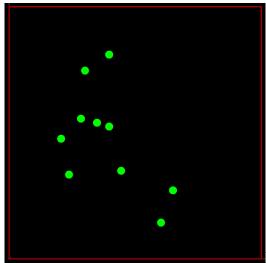


Fig. 16 Layer neelectric Solder Mask Bottom

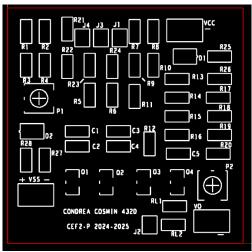


Fig. 17 Layer neelectric Silk Screen Top

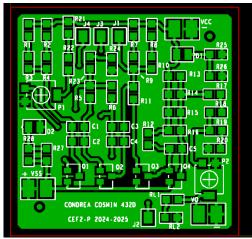


Fig. 18 TOP+SSTOP

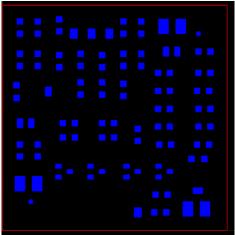


Fig. 19 Layer neelectric Solder Paste Mask Top

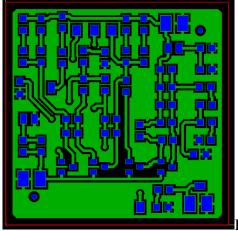


Fig. 20 TOP + SPTOP

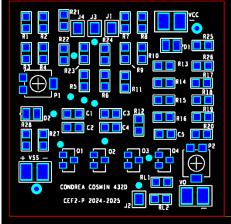


Fig. 21 SSTOP + SPTOP + SMTOP

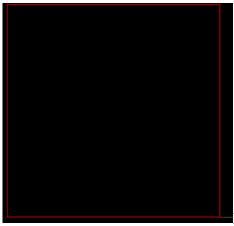


Fig. 22 Layer neelectric Board Outline

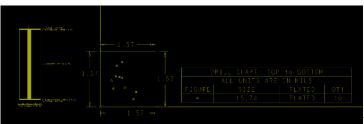


Fig. 23 Fabrication Drawing

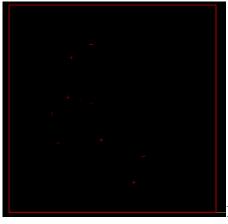


Fig. 24 Drill

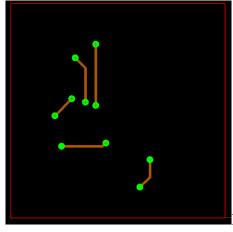


Fig. 25 SMBOT + DRILL + BOTTOM

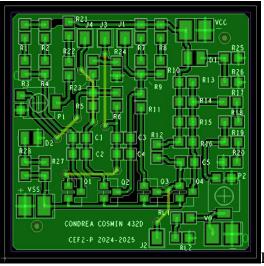


Fig. 26 Layout

Componente

Nr. Crt.	Total	Denumire	Valoare
1	4	C1,C2,C3,C4	1n
2	1	C5	47p
3	2	D1,D2	LED
4	3	P1,R17,R20	10k
5	2	P2,R11	100k
6	2	Q1,Q2	QBC817-25
7	2	Q3,Q4	QBC846B
8	1	RL1	6.8k
9	1	RL2	2.2k
10	9	R1,R2,R3,R4,R7,R8,R9,R10,R24	1k
11	2	R5,R6	8k200
12	1	R12	3.3k
13	4	R13,R14,R15,R16	3k9
14	1	R18	8.2k
15	1	R19	15k
16	2	R21,R22	330
17	1	R23	3k3
18	4	R25,R26,R27,R28	680

Bibliografie

- 1. G. Brezeanu, F. Drăghici, Circuite electronice fundamentale, Ed. Niculescu, București, 2013;
- 2. G. Brezeanu, F. Draghici, F. Mitu, G. Dilimot, *Circuite electronice fundamentale probleme*, Editura Rosetti Educational, Bucuresti, editia II–2008;
- 3. G. Brezeanu, F. Draghici, F. Mitu, G. Dilimot, *Dispozitive electronice probleme*, Editura Rosetti Educational, Bucuresti, 2009;
- 4. Sedra Smith, Microelectronic Circuits seventh edition, Editura Oxford University Press
- 5. Norocel Codreanu, Ciprian Ionescu, Mihaela Pantazică, Alina Marcu, "Tehnici CAD de realizare a modulelor electronice suport de curs și laborator", Editura Cavallioti, PIM, Iași, Decembrie 2017;